特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

REC'D	1	3	OCT	2005
WIPO	_			PC

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人

の書類記号 P33313-P0	ラ接の子がほとにういては、様式にもエク	11 117 410 25 117 5 2 2 3
国際出願番号 PCT/JP2004/012904	国際出願日 (日. 月. 年) 31.08.2004	優先日 (日.月.年) 22.09.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ H01L27/0	04, 21/82, 21/66	
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社	·	
法施行規則第57条(PCT36条) 2. この国際予備審査報告は、この表紹 3. この報告には次の附属物件も添付さ a.	 (を含めて全部で 4 ページれている。 3 ページである。 基礎とされた及び/又はこの国際予備審査(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号を示したように、出願時における国際出願の 	ジからなる。 機関が認めた訂正を含む明細 書、 請求の範
b. 「 電子媒体は全部で 配列表に関する補充概に示 ブルを含む。 (実施細則第		(電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー
□ 第IV欄 発明の単一位□ 第V欄 PCT35条	を報告の基礎 歩性又は産業上の利用可能性についての国際 生の欠如 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の 文献及び説明 用文献 下備	

国際予備審査の請求書を受理した日 25.02.2005	国際予備審査報告を作成した日 26.09.2005
名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 L 3 1 2 5
日本国特許庁 (I PEA/JP) 郵便番号100-8915	宇多川勉
東京都千代田区設が関三丁目 4番 3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3498

第I棚	報告の基礎						
	1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の官語を基礎とした。						
Г : Г Г	この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査						
2. この た差替え	報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)						
Γ	出願時の国際出願書類						
▽	明細 書 第 1, 3-6 ページ、出願時に提出されたもの 第 2, 2/1 ページ*、25.02.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの						
	請求の範囲 項、出願時に提出されたもの 第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項*、25.02.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 項*、 一 付けで国際予備審査機関が受理したもの						
	図面 第 1 - 8						
「配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充概を参照すること。 3. 「補正により、下記の書類が削除された。							
3. 1	 □ 明細書 第						
4. F	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) 「明細書 第						
* 4	. に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。						

 第V概 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを取付ける文献及び説明

 1. 見解

 新規性 (N)
 請求の範囲 1-4 有 無

 進歩性 (IS)
 請求の範囲 1-4 有 無

 産業上の利用可能性 (IA)
 請求の範囲 1-4 有 無

 産業上の利用可能性 (IA)
 請求の範囲 1-4 有 無

 無
 無

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 2003-124274 A (松下電器産業株式会社)

2003.04.25,全文,全図 &

US 2003/0032263 A1,全文,全図 &

CN 1405867 A & KR 3014637 A &

TW 558772 B

文献2: JP 7-37943 A (東京エレクトロン株式会社)

1995.02.07,段落【0004】

文献3:JP 2002-22809 A (セイコーエプソン株式会社)

2002.01.23,段落【0023】-【0026】,第2図

請求の範囲1-4に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

第四個 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細沓及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細帯による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲2は、明細書によって十分に裏付けされていない。請求の範囲2に関しては、 具体的にどのようなパッド同士をバンプによって接触させるのか明細書中に記載され ておらず、単に隣接するパッド同士をバンプによって接触させるのか不明である。 ればならないという制約がある。一定の距離が確保されないと、バンプを形成することができず、その結果、ウェハレベルバーンインを正確に実施できなくなる。このことから、半導体集積回路のチップ面積の縮小化に伴い1ウェハ当りの半導体集積回路の数が増加すると、半導体集積回路1チップ当りのバンプ数を少なくしなければならなくなる。このため、半導体集積回路のチップ面積を縮小化すると、半導体ウェハ上にあるすべての半導体集積回路のすべてのパッドをバンプによって固定することができなくなり、その結果、ウェハレベルバーンインを実施することができなくなる場合があった。

よって、本発明では、チップ面積を縮小化しても、ウェハレベルバーンインを 10 実施することができる半導体集積回路を提供することを目的とする。

発明の開示

5

15

25

上記課題を解決するために、本発明の請求の範囲第1項に係る半導体集積回路は、パッドと、前記パッドと電気的に接続する配線とを備え、前記配線が、前記パッドが配置される領域以外、かつ、パッドと同一の半導体集積回路内部の領域で、プローブカードのバンプと接触するようにした。これにより、ウェハレベルバーンインを実施する場合において、パッドを配置する領域に影響されることなく、半導体集積回路のチップ面積を縮小化することができ、チップの作製にかかるコストを抑えることができる。

20 また、本発明の請求の範囲第2項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第1項に記載の半導体集積回路において、少なくとも2つの前記配線が、1つの前記バンプと接触するようにした。これにより、半導体集積回路のチップ面積を縮小化しても、半導体ウェハ上のすべての半導体集積回路に対してウェハレベルバーンインを実施することが可能になる。

また、本発明の請求の範囲第3項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第2項 に記載の半導体集積回路において、前記配線が、少なくとも1つの屈曲部または 角部を有するようにした。これにより、プローブカードのバンプと配線との接触 領域である電極部の面積をより広く確保でき、コンタクト性を向上させることが できる。 また、本発明の請求の範囲第4項に係る半導体集積回路は、請求の範囲第2項

Best Available Copy

請求の範囲

1. (補正後) パッドと、

前記パッドと電気的に接続する配線とを備え、

- 5 前記配線は、前記パッドが配置される領域以外、かつ、パッドと同一の半導体 集積回路内部の領域で、プローブカードのバンプと接触することを特徴とする半 導体集積回路。
- 2. 請求の範囲第1項に記載の半導体集積回路において、 少なくとも2つの前記配線が、互いに接することなく、1つの前記バンプと接 10 触することを特徴とする半導体集積回路。
 - 3. 請求の範囲第2項に記載の半導体集積回路において、 前記配線は、少なくとも1つの屈曲部または角部を有することを特徴とする半 導体集積回路。
 - 4. 請求の範囲第2項に記載の半導体集積回路において、
- 15 前記配線は切り離し部を有することを特徴とする半導体集積回路。

Best Available Copy